

образователя был выбран существенно меньшим радиуса линзы, то обобщенная апертурная функция определяется не функцией зрачка акустической линзы, а распределением поля пьезообразователя в ее задней фокальной плоскости. В связи с этим был произведен расчет распределения поля в плоскости, удаленной на расстояние  $\Delta$  от поршневого круглого излучателя с радиусом, равным радиусу преобразователя. Как видно из сравнения экспериментальных данных и расчетной кривой, смещенной относительно акустической оси на величину  $\Delta x = 0.17$  мм, наблюдается удовлетворительное соответствие.

### Список литературы

- [1] Atalaar A. // Electron. lett. 1979. V. 15. N 11. P. 321-323.
- [2] Кулаков М.А., Морозов А.И. // Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10. В. 16. С. 984-988.
- [3] Liang K.K., Kino G.S., Khuri-Yakub B.T. // IEEE Trans. 1985. V. SU-32. N 2. P. 213-224.
- [4] Гудмен Дж. Введение в фурье-оптику. М., 1970. 364 с.

Московский институт радиотехники,  
электроники и автоматики

Поступило в Редакцию  
27 апреля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 14  
07

26 июля 1989 г.

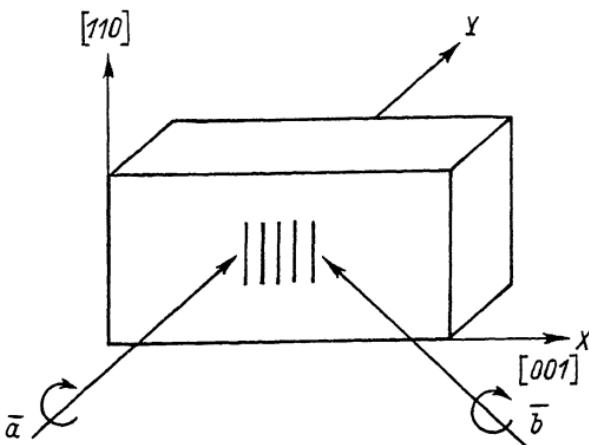
### ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОГИРАЦИЯ В КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ $Bi_{12}TiO_{20}$

М.С. Бродин, В.И. Волков,  
Н.В. Кухтарев, А.В. Привалко

Самодифракция когерентных световых волн в различных нелинейных средах широко используется для усиления и обработки изображений [1, 2], для реализации адаптивной голограммической интерферометрии [3] и других применений динамической голограммы [4].

Актуальной задачей динамической голограммы является поиск новых механизмов записи и регистрирующих сред, повышающих эффективность взаимодействия волн.

Ниже описан новый механизм записи динамических голограмм (самодифракционная (голограммическая) электрогориация), реализованный в кристалле класса симметрии 23  $Bi_{12}TiO_{20}$ .



При взаимодействии двух когерентных волн (см. рисунок) в кристалле возникает картина интерференции, которая вследствие фотогенерации, диффузионно-дрейфового перераспределения и рекомбинации носителей приводит к появлению решетки электрического поля. Если вектор решетки электрического поля  $\vec{q} \parallel [001]$ , то в кристалле возникают голографические решетки вследствие электрооптического и электротрениционного эффектов [3].

Для расчета амплитуды волны  $\alpha$  получаем уравнения [3] в циркулярном базисе

$$\frac{d\alpha_{\pm}}{dy} = \mp iG\alpha_{\pm} - i\Delta E \left[ \frac{r}{2}(b_+ + b_-) \pm g b_{\pm} \right] \quad (1)$$

где  $G$  – удельная оптическая активность,  $r = \frac{\omega^3 r_{14} k_0}{2 \cos \theta}$ ;  $g = \frac{k_0 g_{14}}{2 \omega}$ ,

$r_{14}, g_{14}$  – электрооптический и электротрениционный коэффициенты,  $k_0$  – волновое число,  $\omega$  – показатель преломления,  $\Delta E$  – амплитуда решетки электрического поля. При импульсном возбуждении, когда длительность прямоугольного импульса  $\tau_u \ll \tau_m$ , получаем для  $\Delta E$  [3]

$$\Delta E = \frac{i E_d \Delta I \tau_u}{I_0 \tau_m} \left\{ 1 + \frac{\tau_g}{\tau_m} \left[ \exp \left( -\frac{\tau_u}{\tau_g} \right) - 1 \right] \right\} \equiv i \Delta I F_s, \quad (2)$$

где  $\Delta I$  – амплитуда модуляции интенсивности,  $\tau_g^{-1}$  – скорость генерации носителей,  $I_0$  – суммарная интенсивность,  $E_d$  – диффузионное поле [3].

Для относительного изменения интенсивности в линейном приближении получаем

$$z_{\pm} = F_s \left( \frac{r}{2} \pm g \right) |b_{\pm}^o|^2 y_o, \quad (3)$$

где индексы  $\pm$  соответствуют взаимодействию волн правой и левой циркулярной поляризации. Из [1, 3] следует, что в зависимости от состояния поляризации взаимодействующих волн (правая или левая циркуляция) вклады от дифракции на электрооптической и электротогиационной решетках складываются или вычитаются, что и приводит к усилению или ослаблению энергообмена.

В эксперименте использовался одномодовый рубиновый лазер ( $\lambda = 694.3$  мм), генерирующий импульсы длительностью 15 нс с энергией  $\sim 30$  мДж. Угол схождения пусков составлял  $17^\circ$  (период решетки  $L = 2$  мкм), входное соотношение интенсивностей  $(\frac{a}{b})^2 \approx 0.05$ , толщина кристалла  $y_0$  была равна 0.82 см.

Из сопоставления теории с экспериментом можно определить коэффициент электротогиации кристалла  $Bi_{12}TiO_{20}$ , что дает при  $\zeta_+ = 10\%$ ,  $\zeta_- = 3\%$ ,  $r_{14} = 5.2 \cdot 10^{-10}$  В/см,  $\alpha = 2.55$  величину  $g_{14} \approx 6 \cdot 10^{-9}$  см/В, которая согласуется с оценками  $g_{14}$ , приведенными в работах [3, 5].

Описанный новый механизм записи голограммических решеток увеличивает энергообмен световых волн и может быть реализован также в других кристаллах, обладающих электротогиационным эффектом.

#### Список литературы

- [1] Винецкий В.Л., Кухтарев Н.В., Одолов С.Г., Соскин М.С. // УФН. 1979. Т. 129. С. 113.
- [2] Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.П. Фоточувствительные электрооптические среды в голограммии и оптической обработке информации. Л.: Наука, 1983. С. 269.
- [3] Кухтарев Н.В., Муравьев В.В., Семенец Т.И. // Препринт ИФ АН УССР. 1986. № 19. С. 22.
- [4] Винецкий В.Л., Кухтарев Н.В. Динамическая голограммия. К.: Наукова думка, 1983. С. 126.
- [5] Fox A.G., Brutton T.M. // Appl. Phys. Lett. 1975. V. 27. P. 361-363.

Институт физики АН Украинской ССР

Поступило в Редакцию  
14 декабря 1988 г.